

■ 产品简介

74LVC1G14 是一款的施密特触发功能的非门集成电路, 可实现 $Y = \bar{A}$ 的数学逻辑运算。采用先进 CMOS 工艺设计, 具有低功耗和高输出驱动能力的工作特点, 电源电压 VCC 在 1.65V 和 5.5V 之间芯片均可正常工作。并且 74LVC1G14 具有多种小型封装外形, 可广泛应用于高端精密仪器和小型化低功耗的手持设备, 以及人工智能等领域。

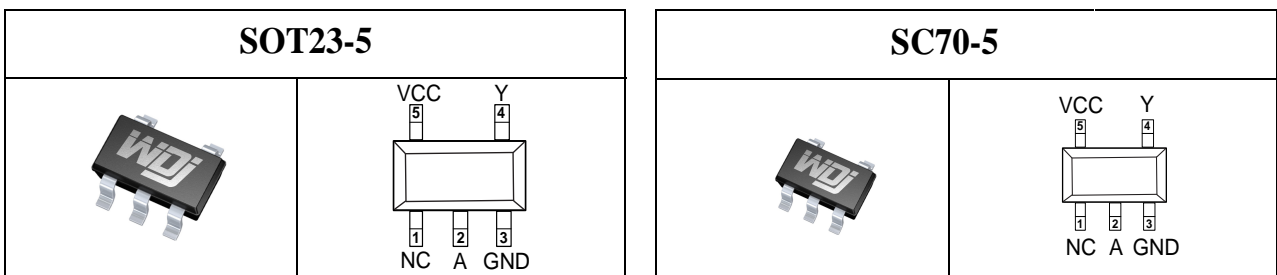
■ 产品特点

- 低输入电流: 典型值 0.1uA
- 低静态功耗: 典型值 0.1uA
- 高输出驱动: VCC=4.5V, 大于 32MA
- 宽工作电压范围: 1.65V to 5.5V
- 封装形式: DBV/DCK/DRL/YZP/ DRY/DSF/ DPW

■ 产品用途

- 便携式音频接口
- 数字电视
- 无线耳机, 智能手表等
- 蓝光播放器和家庭影院
- 固态硬盘
- 智能穿戴设备

■ 封装形式和管脚功能定义



名称	管脚		说明
	SOT23-5 (DBVRW)	SC70-5 (DCKRW)	
NC	1	1	空脚
A	2	2	输入
GND	3	3	电源地
Y	4	4	输出
V _{CC}	5	5	电源正

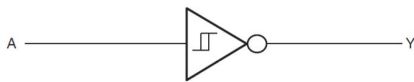
■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
工作电压	V_{CC}	6.5	V
输入	V_{IN}	-0.5~6.5	V
输出电压 (1)	V_{OUT}	-0.5~6.5	V
单个管脚输出电流	I_{OUT}	25	mA
V_{CC} 或 GND 电流	I_{CC}	50	mA
存储温度	T_s	-65~150	°C
引脚焊接温度	T_w	260, 10s	°C

注：1、在 $V_{CC}=0V$ 断电状态下，输出所能承受的极限电压，

2、极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

■ 原理逻辑图



■ 真值表

Inputs		Output
A		Y
L		H
H		L

■ 工作条件

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}	-	1.65	-	5.5	V
输入高电平电压	V_{IH}	$V_{CC} = 1.65V \sim 1.95V$	$0.65 * V_{CC}$	-	-	V
		$V_{CC} = 2.3V \sim 2.7V$	1.7V	-	-	
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$	$0.7 * V_{CC}$	-	-	
输入高电平电压	V_{IH}	$V_{CC} = 1.65V \sim 1.95V$	-	-	$0.35 * V_{CC}$	V
		$V_{CC} = 2.3V \sim 2.7V$	-	-	0.7	
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$	-	-	$0.3 * V_{CC}$	
输入电压	V_I	-	0	-	5.5	V
输出电压	V_O	-	0	-	V_{CC}	V
高电平输出电流	I_{OH}	$V_{CC} = 1.65V$	-	-	-4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$	-	-	-8	
		$V_{CC} = 3V$	-	-	-16	
		$V_{CC} = 4.5V$	-	-	-32	
低电平输出电流	I_{OL}	$V_{CC} = 1.65V$	-	-	4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$	-	-	8	
		$V_{CC} = 3V$	-	-	16	
		$V_{CC} = 4.5V$	-	-	32	

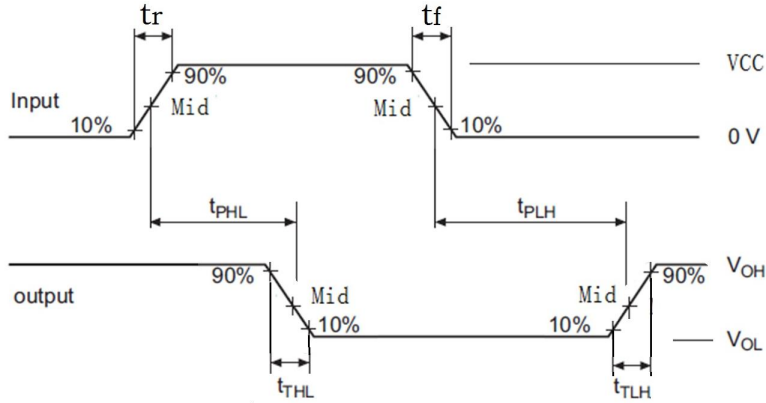
■ 电学特性

直流电学特性: $T_A=25^{\circ}\text{C}$

项目	符号		测试条件	V _{CC}	典型值	最大值	单位
上临界电压	V _{T+}		-	1.65V	1	-	V
				2.3V	1.35	-	
				3V	1.7	-	
				4.5V	2.5	-	
				5.5V	3	-	
下临界电压	V _{T-}		-	1.65V	0.5	-	V
				2.3V	0.7	-	
				3V	1.1	-	
				4.5V	1.65	-	
				5.5V	1.9	-	
滞后宽度电压	ΔV_T (V _{T+} - V _{T-})		-	1.65V	0.5	-	V
				2.3V	0.65	-	
				3V	0.6	-	
				4.5V	0.85	-	
				5.5V	1.1	-	
高电平负载电压	V _{OH}		I _{OH} = -100uA	1.65V~5.5V	1.64	-	V
			I _{OH} = -4 mA	1.65V	1.47	-	
			I _{OH} = -8 mA	2.3V	2.15	-	
			I _{OH} = -16 mA	3V	2.73	-	
			I _{OH} = -32 mA	4.5V	4.0	-	
低电平负载电压	V _{OL}		I _{OH} = 100uA	1.65V~5.5V	0.01	-	V
			I _{OH} = 4 mA	1.65V	0.11	-	
			I _{OH} = 8 mA	2.3V	0.11	-	
			I _{OH} = 16 mA	3V	0.2	-	
			I _{OH} = 32 mA	4.5V	0.35	-	
输入电流	I _I	A	V _I = 5.5V 或 GND	0~5.5V	0.01	±5	uA
关断电流	I _{OFF}	V _I	V _I = 5.5V	0	0.01	±10	uA
		V _O	V _O = 5.5V	0	0.01	±10	
工作电流	I _{CC}	V _I = 5.5V, I _O = 0	1.65V~5.5V	0.01	10	uA	
		V _I = GND, I _O = 0					0.01
工作电流变化值	ΔI_{CC}	A = V _{CC} - 0.6V	3V~5.5V	25	-	uA	

交流电学特性: $T_a=25^{\circ}\text{C}$ $V_{CC}=5.0\text{V}$, $t_r=t_f \leq 20\text{ns}$ 见测试方法。

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
最大传输延迟时间 A、B to Y	t_{PHL}	$C_L=15\text{pF}$	-	20	-	ns
	t_{PLH}	$C_L=15\text{pF}$	-	20	-	ns

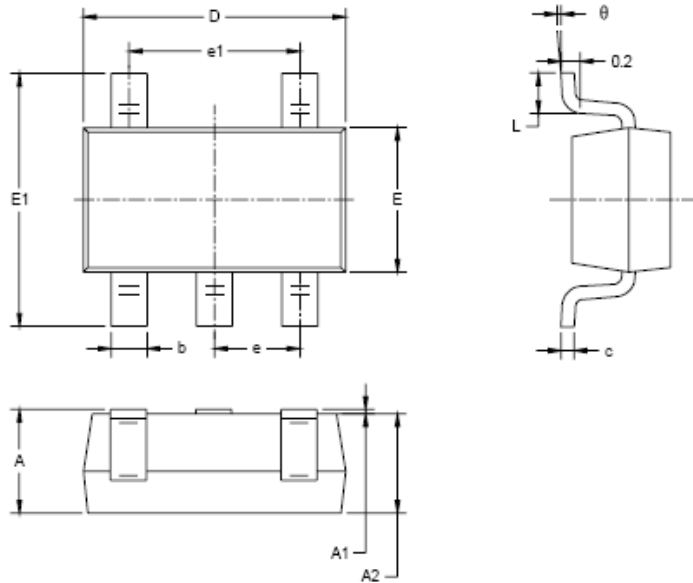


- 注: 1、 C_L 电容为外接贴片电容 (0603), 靠近输出管脚接入, 电容地靠近芯片GND;
 2、Input: 端口输入电平, $f=500\text{kHz}$, $D=50\%$; $t_r=t_f \leq 20\text{ns}$;
 3、Output: Y 端输出测试。

■ 封装信息

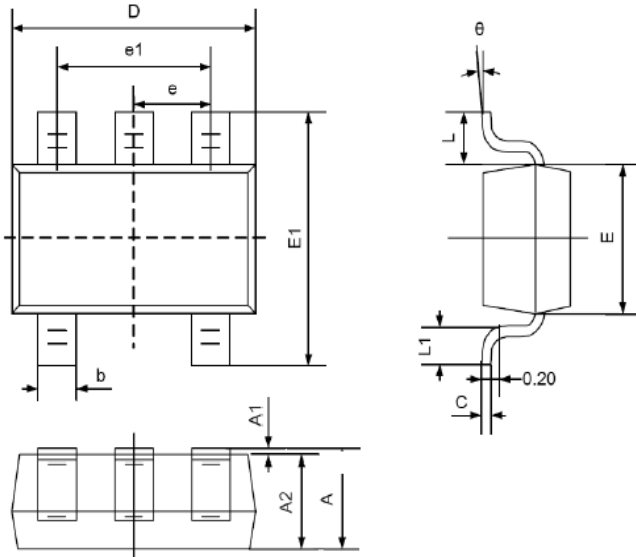
单位：毫米 / 英寸

DBVRW (SOT23-5)



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 BSC		0.037 BSC	
e1	1.900 BSC		0.075 BSC	
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

DCKRW (SC70-5)



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.900	1.100	0.035	0.043
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.000	0.035	0.039
b	0.150	0.350	0.006	0.014
C	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.000	2.200	0.079	0.087
E	1.150	1.350	0.045	0.053
E1	2.150	2.450	0.085	0.096
e	0.650TYP		0.026TYP	
e1	1.200	1.400	0.047	0.055
L	0.525REF		0.021REF	
L1	0.260	0.460	0.010	0.018
θ	0°	8°	0°	8°

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>WDJ\(微电晶\)](#)